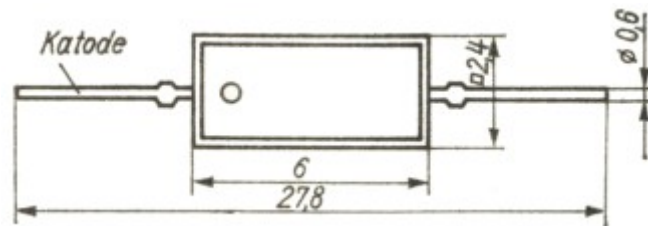


RFT SA418

Silizium- Epitaxie- Diode im Plastgehäuse für Anwendungen in der Digital-, NF- und HF- Technik



Grenzwerte

bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$

Sperrgleichspannung	U_R	=	80V
Durchlaßgleichstrom	I_F	=	100mA
Gesamtverlustleistung	P_{tot}	=	100mW
Betriebstemperatur	ϑ_a	=	-25 ... +85°C
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	=	125°C

Kennwerte

bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$

Durchlaßgleichspannung bei $I_F = 100\text{mA}$	U_F	\leq	1,2V
Sperrgleichstrom	I_R	\leq	0,5uA
Nullpunktkapazität bei $U_R = 0\text{V}$, $f=0,5\text{MHz}$	C_O	\leq	8pF
Sperrerholungszeit	t_{rr}	\leq	1000ns ^{*)}

*) beim Schalten von $I_F = 10\text{mA}$ auf $U_R = 6\text{V}$,
gemessen bei $I_R = 1\text{mA}$; $R_L = 50\ \Omega$

Quelle: Aktive elektronische Bauelemente – 1985 & 1989